

Технологический суверенитет в контексте соперничества США, КНР и России

Научный руководитель – Васильева Галина Михайловна

Полухина Виктория Дмитриевна

Аспирант

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
Новосибирск, Россия

E-mail: viktoriapoluhina72588@gmail.com

Технологический суверенитет становится важным аспектом глобальной политики, определяя стратегию ведущих государств в условиях растущей конкуренции за критически важные технологии. В отличие от классического промышленного протекционизма, современные меры обеспечения технологической автономии включают не только поддержку национального производства, но и контроль за распространением технологий, ограничения на трансграничный обмен знаниями, а также использование санкционных механизмов.

Согласно неореализму по Waltz K., государства вынуждены обеспечивать свою безопасность и независимость в условиях анархичной международной системы, а технологическое превосходство становится одним из главных инструментов достижения этих целей [13]. Исследования Gilpin R. показывают, что технологическое лидерство формирует глобальные экономические и политические режимы, обеспечивающие преимущество ведущих держав [8]. Технологический суверенитет рассматривается в рамках нескольких научных направлений. В работе Nye J. подчеркивается, что контроль над технологиями является формой «мягкой силы», позволяющей государствам не только доминировать в экономике, но и формировать международные стандарты [10]. В том числе технологический национализм, проявляющийся в протекционистской политике государств, становится неизбежным элементом современного технологического развития [5].

Сейчас глобализация привела к тому, что технологическая интеграция стала важнейшим фактором международной стабильности [9]. Однако современные тенденции показывают, что государства все чаще отказываются от глубокой технологической кооперации в пользу национальных стратегий автономии [1]. США традиционно занимают лидирующие позиции в области передовых технологий, однако в последние десятилетия их преимущество оказалось под угрозой из-за роста технологического потенциала Китая. В ответ Вашингтон принял ряд стратегических решений, направленных на сохранение глобального доминирования в критически важных секторах. Принятый в 2022 году Закон о производстве полупроводников и научных исследованиях предусматривает выделение \$52 млрд. на развитие национальной микроэлектронной промышленности [6]. В дополнение к этому США усилили экспортный контроль, ограничив доступ Китая к передовым литографическим технологиям [7].

Китайская же политика в сфере технологического развития направлена на снижение зависимости от западных поставщиков. Программа «Made in China 2025» ориентирована на локализацию производства высокотехнологичных товаров, включая полупроводники, 5G и суперкомпьютеры [12]. Несмотря на санкции США, Китай продолжает развивать собственные технологические экосистемы. В 2023 году китайская компания SMIC представила 7-нм чип, произведенный без доступа к американскому оборудованию [11].

Санкции 2022 года значительно ограничили доступ России к западным технологиям, что ускорило процесс импортозамещения. В рамках национальной программы цифровой

экономики были запущены проекты по развитию отечественных операционных систем, облачных сервисов и микроэлектроники. Основным вызовом для России остается нехватка современных литографических технологий, необходимых для производства чипов. В этой связи укрепляет сотрудничество с Китаем, который поставляет оборудование и компоненты для российских компаний (РСПП, 2023).

Согласно отчету McKinsey Global Institute (2023), усиление технологического протекционизма может привести к снижению глобального ВВП на 5% к 2030 году. Данная тенденция связана с ростом затрат на разработку альтернативных технологий и снижением уровня международного сотрудничества. В долгосрочной перспективе формирование двух технологических блоков — может привести к дальнейшей эскалации экономических конфликтов и замедлению инновационного развития. Усиление технологического протекционизма создает риски для глобальной стабильности. В этом контексте поиск механизмов международного сотрудничества станет критически важным фактором будущего мирового порядка.

Источники и литература

- 1) Афанасьев А.А. Технологический суверенитет: варианты подходов к рассмотрению проблемы // Вопросы инновационной экономики. – 2023. – Т. 13, № 2. – С. 689–706.
- 2) Бородушко И.В. Технологический суверенитет России: теоретико-правовые основы, механизмы достижения // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2023. – № 3. – С. 86–96.
- 3) Капогузов Е.А., Пахалов А.М. Технологический суверенитет: концептуальные подходы и восприятие российскими академическими экспертами // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2024. – № 3 (64). – С. 244–250.
- 4) Степанова Т.Д. Технологический суверенитет России как элемент экономической безопасности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12, № 9А. – С. 362–372.
- 5) Breznitz D. Innovation in Real Places: Strategies for Prosperity in an Unforgiving World. Oxford: Oxford University Press, 2021. – 288 p.
- 6) Congress USA. CHIPS and Science Act (H.R.4346) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/4346>, свободный. – (Дата обращения: 13.02.2025).
- 7) Gibson Dunn. 2023 Year-End Sanctions and Export Controls Update [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gibsondunn.com/2023-year-end-sanctions-and-export-controls-update/>, свободный. – (Дата обращения: 13.02.2025). Zhao S. Made in China 2025: China's Strategy for Becoming a Global High-Tech Leader. // Journal of Chinese Economic and Business Studies. – 2022. – Vol. 20, No. 3. – P. 197-215.
- 8) Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, 2001. – 436 p.
- 9) Keohane R., Nye J. Power and Interdependence. Boston: Longman, 2001. – 365 p.
- 10) Nye J. The Future of Power. New York: PublicAffairs, 2011. – 320 p.
- 11) South China Morning Post. Huawei's Pura 70 smartphone contains new 7-nm HiSilicon chip made by top Chinese foundry SMIC, says TechInsights, 2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3260693/huaweis-pura-70-smartphone-contains-new-7-nm-hisilicon-chip-made-top-chinese-foundry-smic-says?utm_source=chatgpt.com. – (Дата обращения: 13.02.2025).

- 12) South China Morning Post. Huawei's China-made chip used US gear from Applied Materials and Lam Research, complicating self-sufficiency narrative, 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3254612/huaweis-china-made-chip-used-us-gear-applied-materials-and-lam-research-complicating-self> – (Дата обращения: 13.02.2025).
- 13) Waltz K. Theory of International Politics. New York: McGraw-Hill, 1979. – 129 p.